



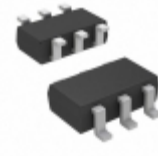




	<h2>SI3424BDV-T1-E3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI3424BDV-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 8A 6TSOP</p> <p>Datenblätter:  SI3424BDV-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 51390 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI3424BDV-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 8A 6TSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	51390 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 8A (Tc) 2.1W (Ta), 2.98W (Tc) Surface
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Verlustleistung (max)	2.1W (Ta), 2.98W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	28 mOhm @ 7A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	19.6nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	735pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

SI3424BDV-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI3424BDV-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3424BDV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3424BDV-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI3422DV Vishay SI3422DV Vishay</p>	 <p>SI3424CDV-T1-E3 VISHAY SI3424CDV-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SI3424BDV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 8A 6TSOP</p>	 <p>SI3424CDV-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 8A 6-TSOP</p>
 <p>SI3424CDV V SI3424CDV V</p>	 <p>SI3424BDV-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 8A 6TSOP</p>	 <p>SI3422DV-T1-GE3 Vishay Precision Group SI3422DV-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p>SI3422DV-T1 VISHAY SI3422DV-T1 VISHAY</p>

heiße Teile

Mehr

SI3241-FQ	SI3241-GQ	SI32919-A-FS	SI32919-A-FSR	SI32919A-FSR
SI3402-A-GMR	SI3402-GM	SI3403DV-T1-GE3	SI3407DV-T1-E3	SI3407DV-T1-E3
SI3407DV-T1-GE3	SI3407DV-T1-GE3	SI3410DV-T1-E3	SI3410DV-T1-E3	SI3410DV-T1-GE3
SI3410DV-T1-GE3	SI3417DV-T1-GE3	SI3417DV-T1-GE3	SI3420DV-T1-GE3	SI3421DV-T1-GE3
SI3421DV-T1-GE3	SI3422DV	SI3422DV-T1	SI3422DV-T1-GE3	SI3424BDV
SI3424BDV-T1-E3	SI3424BDV-T1-GE3	SI3424BDV-T1-GE3	SI3424CDV	SI3424CDV-T1-E3
SI3424CDV-T1-GE3	SI3424CDV-T1-GE3	SI3424DV-T1	SI3424DV-T1-E3	SI3424DV-T1-E3
SI3424DV-T1-GE3	SI3424DV-T1-GE3	SI3424DV-TI-E3	SI3425DV	SI3429EDV-T1-GE3
SI3429EDV-T1-GE3	SI3430DV-T1	SI3430DV-T1-GE3	SI3430DV-T1-GE3	SI3433BDV-T1
SI3433BDV-T1-E3	SI3433BDV-T1-E3	SI3433BDV-T1-GE3	SI3433BDV-T1-GE3	SI3433CDV-T1-E3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited